

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年8月22日(22.08.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/171706 A1

- (51) 国際特許分類:
C01B 33/02 (2006.01) G06T 7/60 (2017.01)
G01N 33/00 (2006.01) G06T 7/62 (2017.01)
G06T 7/00 (2017.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/001203
- (22) 国際出願日: 2024年1月18日(18.01.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-021138 2023年2月14日(14.02.2023) JP
- (71) 出願人: 株式会社 トクヤマ (TOKUYAMA CORPORATION) [JP/JP]; 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 Yamaguchi (JP).
- (72) 発明者: 西川 正芳 (NISHIKAWA, Masayoshi); 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 株式会社 トクヤマ内 Yamaguchi (JP). 植杉

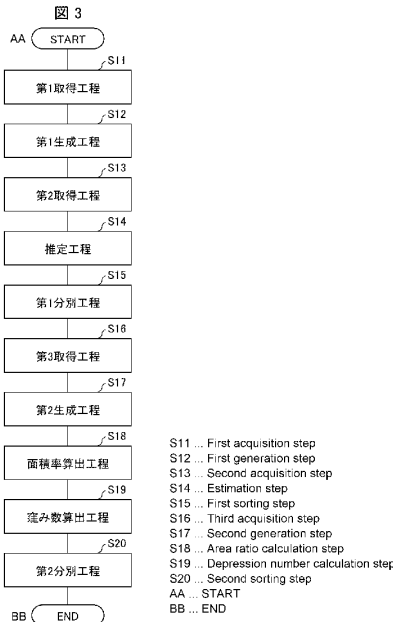
真也 (UESUGI, Shinya); 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 株式会社 トクヤマ内 Yamaguchi (JP). 吉村 聡子 (YOSHIMURA, Satoko); 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 株式会社 トクヤマ内 Yamaguchi (JP).

(74) 代理人: 弁理士 法人 H A R A K E N Z O W O R L D P A T E N T & T R A D E M A R K (HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK); 〒5300041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和南森町ビル Osaka (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,

(54) Title: METHOD FOR ESTIMATING EASE OF FINE POWDER OCCURRENCE IN POLYSILICON, ESTIMATION DEVICE, METHOD FOR PRODUCING POLYSILICON, TRAINED MODEL GENERATION DEVICE AND GENERATION METHOD

(54) 発明の名称: ポリシリコンにおける微粉発生のしやすさの推定方法、推定装置、ポリシリコンの製造方法、学習済みモデルの生成装置および生成方法



(57) Abstract: The ease of occurrence of fine powder in polysilicon is estimated. Provided is a method for estimating the ease of fine powder occurrence in polysilicon that includes an estimation step that estimates the ease of occurrence of fine powder when vibration is applied to a second polysilicon from second imaging data that include images of the second polysilicon to be estimated, using a first trained model generated using as teaching data determination data on whether the amount of fine powder occurring due to vibration is at or below a first threshold in a first polysilicon to which vibration has been applied under predetermined conditions and first imaging data that include images of the first polysilicon.

(57) 要約: ポリシリコンにおける微粉の発生のしやすさを推定する。ポリシリコンにおける微粉発生のしやすさの推定方法であって、所定条件の振動が与えられた第1ポリシリコンにおいて、振動による微粉の発生量が所定の第1閾値以下であるか否かの判定データと、第1ポリシリコンの画像を含む第1撮像データと、を教師データとして生成された第1学習済みモデルを用いて、推定対象である第2ポリシリコンの画像を含む第2撮像データから、第2ポリシリコンにおける、振動が与えられた際の微粉の発生のしやすさを推定する推定工程を含む。

[続葉有]

LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))